

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Якимов Евгений Борисович
2	Дата рождения (полная)	17 ноября 1947
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук (специальность 01.04.10)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	142432, Московская область, Черноголовка, ул. акад. Осипьяна, д.6 http://www.iptm.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
	Ведомственная принадлежность организации	РАН
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов
	Должность	Главный научный сотрудник
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пещерова С.М., Якимов Е.Б., Непомнящих А.И., Павлова Л.А., Феклисова О.В., Пресняков Р.В. Электрическая активность протяженных дефектов в мультикремнии. Физика и техника полупроводников, 52 (2) С.266-271 (2018) 2. Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Yakimov E.B., Tarelkin S.A., Turutin A.V., Shemerov I.V., Pearton S.J., Bae K.B., Lee I.H. Deep traps determining the non-radiative lifetime and defect band yellow luminescence in n-GaN. Journal of alloys and compounds, 686 C.1044-1052 (2016) 3. Rabinovich O., Legotin S., Didenko S., Yakimov E., Osipov Y., Fedorchenko I. Heterostructure optimization for increasing LED efficiency. Japanese journal of applied physics, 55 (2) C.05fj13 (2016) 4. Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Yakimov E.B., Lee I.H., Pearton S.J. Electrical, luminescent, and deep trap properties of Si doped n-GaN grown by pendeo epitaxy. Journal of Applied Physics, 119 (1) 015103 (2016) 5. Yakimov E.B. What is the real value of diffusion length in GaN? Journal of Alloys and Compounds, 627 C.344-351 (2015) 6. Малин Т.В., Гишинский А.М., Мансуров В.Г., Протасов Д.Ю., Шестаков А.К., Якимов Е.Б., Журавлев К.С. Синтез AlGaIn/GaN-гетероструктур для ультрафиолетовых фотоприемников методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Журнал технической физики, 85 (4) С.67-73 (2015) 	

	<p>7. Vergeles P.S., Orlov V.I., Polyakov A.Y., Yakimov E.B., Kim T., Lee In-Hwan. Recombination and optical properties of dislocations gliding at room temperature in GaN under applied stress. Journal of Alloys and Compounds 776 (2019) 181-186.</p> <p>8. Orlov V.I., Yakimov E.B. Extended defect study in Si: EBIC versus LBIC. Superlattices and microstructures, 99 C.202-207 (2016)</p> <p>9. Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Shcherbachev K.D., Lee i.H., Govorkov A.V., Yakimov E.B., Usikov A.S., Helava h., Makarov Y.N. Electrical, optical, and structural properties of GaN films prepared by hydride vapor phase epitaxy. Journal of alloys and compounds, 617 C.200-206 (2014)</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты